

Список работ и патентов АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по карбидокремниевой тематике

1. Н. Брюхно, В. Громов, И. Куфтов, М. Степанов, А. Фроликова Отечественные карбидокремниевые диоды Шоттки на токи до 10 А и напряжения 1 200 В ЭЛЕКТРОНИКА наука, технология, бизнес №7 (00178) 2018. – С. 1-3.
2. Громов В., Брюхно Н., Демидов А., Дракин А, Зотин В., Кульченков Е., Рыбалка С. 2018. Исследование стойкости SiC-диодов Шоттки ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» к скорости нарастания обратного напряжения. Силовая электроника. 71(2) 2018. - С.10-12.
3. Н. Брюхно, В. Громов, И. Куфтов, М. Степанов, А. Фроликова. Устойчивость карбидокремниевых диодов Шоттки к воздействию тяжелых заряженных частиц. КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ № 1 2019.- С. 68 -70.
4. Алехин С.С. Формирование микротрещин в поверхностных слоях карбидокремниевых пластин при финишной абразивной обработке [Текст] / С.С. Алехин // Сб. ст. «LVIII Международные научные чтения (Памяти Б.Г. Галеркина)». – Москва: ЕФИР, 2019. – С. 16-19.
5. Бишутин С.Г. Выбор технологических режимов алмазно-абразивной обработки пластин из карбида кремния / С.Г. Бишутин, С.С. Алехин // Научно-технические технологии в машиностроении. – 2020. – №12(114). – С. 3-6.
6. Маска для ионного легирования в пластины карбида кремния (патент № 140712).
7. Кассета для постимплантационного отжига слоев карбида кремния (патент №145241).
8. Кассета для высокочастотного отжига и активации ионно-легированных слоев в карбидокремниевых пластинах (патент №147302).
9. Мощный высоковольтный карбидокремниевый прибор (патент №156624).
10. Силовой диод Шоттки на карбиде кремния (патент №157852).
11. Мощный биполярный транзистор на основе карбида кремния (патент №156549).
12. Высоковольтный диод на основе карбида кремния (патент №165463).
13. Способ контроля качества контактов Шоттки (патент № 2632173).
14. Устройство для зондового контроля параметров кристаллов высоковольтных приборов (патент № 172838).
15. Контейнер для отжига и активации ионно-легированных слоев карбидокремниевых пластин (патент №179406).
16. Диод с барьером Шоттки на основе карбида кремния (патент № 172837).
17. Защитное покрытие полупроводниковых приборов на основе SiC (патент № 166441).